角度分解光電子分光で探るカゴメ格子超伝導体への化学置換効果

加藤剛臣1,中山耕輔1,佐藤宇史1,2

1 東北大学 大学院理学研究科物理学専攻, 2 東北大学 材料科学高等研究所

Chemical Substitution Effects on Kagome Superconductors Studied by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

Takemi KATO¹, Kosuke NAKAYAMA¹, Takafumi SATO^{1,2} ¹Department of Physics, Graduate School of Science, Tohoku University ²Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR), Tohoku University

Abstract

カゴメ格子を結晶構造に持つ金属 CsV₃Sb₅ は電荷密度波(CDW)と超伝導を示すが、そのメカニズムは明らかにされ ていない。本稿では、カゴメ格子を形成する V を Nb で置換して超伝導転移温度を上昇させ、かつ CDW 転移温度を低下 させた Cs(V_{1-x}Nb_x)₃Sb₅ における角度分解光電子分光(angle-resolved photoemission spectroscopy; ARPES)の結果について報 告する。本研究の結果から、カゴメ格子に由来するエネルギーバンドの鞍点構造が CDW の安定化に重要な役割を果たし、 Nb 置換によって鞍点がフェルミ準位から離れることで CDW が抑制されることを明らかにした、また、V と Sb 由来のエ ネルギーバンドが協調して Nb 置換による超伝導転移温度の上昇に寄与していることを見出した。

1. はじめに

カゴメ格子 [Fig. 1(a)] は電子相関と非自明なバンドトポ ロジーに由来するエキゾチックな量子現象を探求するた めの格好の舞台である。歪みの無い理想的なカゴメ格子の バンド構造 [Fig. 1(b)] は、六角形のブリルアンゾーンの波 数空間全域に亘る平坦なバンド,ブリルアンゾーンの角(K 点)のディラックコーン,ブリルアンゾーンの境界(M点) 近傍の鞍点構造から構成される。このような特異なバンド 構造を持つカゴメ格子は、フェルミ準位 (E_F)の位置によ って様々な興味深い物性を示す。例えば E_Fが平坦バンド 近傍に位置する場合には強磁性や分数量子ホール効果, E_F がディラック点近傍に位置する場合にはトポロジカル絶 縁体や磁性ワイル半金属相の実現が提案され、これらに対 応するバンド構造や物性の観測結果が相次いで報告され ている。一方, E_Fが鞍点やその近傍にある場合には, 超 伝導や密度波秩序などの興味深い量子現象が理論的に予 測されているが、鞍点近傍に Er がある物質は稀であるた め、実験的な理解は進んでいなかった。

最近, V原子がカゴメ格子を作る金属 AV_3Sb_5 (A = K, Rb, Cs)[Fig. 1(c)] が発見され [1],密度汎関数理論による バンド計算や ARPES 実験によって鞍点が E_F 付近に存 在することが明らかになり,鞍点構造に関連する現象を 研究する新しいプラットフォームとして注目されている [2]。 AV_3Sb_5 はアルカリ金属 (A)元素の種類によらず超伝 導 ($T_c = 0.9-2.5$ K) と ab 面内 2×2 周期の電荷密度波 (CDW; $T_{CDW} = 78-103$ K)を示す [2-4]。これらのメカニズムは、ブ リルアンゾーンの M 点に鞍点を持つ特徴的なバンド構造 [Fig. 1(b)] の観点から集中的に議論されてきた [4,5]。例え ば,異なる鞍点同士を結ぶ電子散乱は,非従来型の超伝導 を引き起こす可能性がある [6,7]。一方,同一の散乱が面



Figure 1 (a) Kagome lattice. (b) Tight binding band structure of kagome lattice. (c) Crystal structure of Cs(V_{1-x}Nb_x)₃Sb₅. (d) Superconducting and CDW transition temperatures of Cs(V_{1-x}Nb_x)₃Sb₅ plotted against x [10].

内 2×2 の周期性を持つカイラル CDW を安定化する可能性 も指摘されている [4]。

超伝導や CDW と電子状態の関係を実験的に解明する 上での有望な戦略は, 圧力やキャリア濃度など, 電子相 図を特徴づける主要な物理パラメータを変化させた際の バンド構造の変化を調べることである。実際、AV₃Sb₅で も電子相図について詳細な研究が進められている。例え ば、高圧下での輸送測定により、 $T_{c} \ge T_{CDW}$ の間の競合関 係や、二重の超伝導ドーム構造が明らかになってきている [8]。また、元素置換によって化学的圧力やキャリア濃度 を調整した系の電子相図も報告されている [9,10]。例えば, CsV₃Sb₅のカゴメ格子を構成する V を同族の Nb で置換し た Cs(V_{1-x}Nb_x)₃Sb₅ では, Fig. 1(d) に示す相図のように固溶 限界の x = 0.07 まで T_cが単調に上昇する一方で, T_{CDW} は 逆に単調に低下することが明らかになっている [10]。しか し、これらの特徴的な電子相図とバンド構造の関係につい てはほとんど未解明のままとなっている。これまで我々は, AV₃Sb₅及びそれに元素置換やキャリアドープを施した物 質の電子状態について高分解能 ARPES を用いた研究を進 めてきた [11-16]。本稿では、Photon Factory BL-28A など で実施した Nb 置換による物性変調の起源を明らかにした 最近の ARPES 実験結果 [14] を紹介する。

2. Nb 置換したカゴメ格子超伝導体 CsV₃Sb₅の ARPES 2-1. Nb-7% 置換試料の電子状態

まず, Nb を最大限に置換した試料(x = 0.07) での電子 構造を示す。Fig. 2(a) は、T = 120 K (> T_{CDW}) において測 定した $E_{\rm F}$ 上の ARPES 強度を波数 $k_{\rm x}$ と $k_{\rm y}$ の関数としてプ ロットした結果を示している。Fig. 2(a) において Γ 点を中 心とする円形のフェルミ面は、FKM カット(黄破線)に 沿った ARPES 強度 [Fig. 2(b)] に見られるように, 放物線 状のエネルギー分散を示す電子バンドαによって形成さ れている。この α バンドは、カゴメ格子面に埋め込まれ た Sb1 原子 [Fig. 1(c)] の 5p. バンドに由来する。六角形の フェルミ面は直線的な分散を示すバンド β/γ に由来し,主 に V 3dx 軌道と 3dv 軌道(3dx/3dv)に起因する。K 点中 心の三角形のフェルミ面はδバンドとεバンドに由来し, これらは V 3dxv/3dx2-v2 軌道に帰属される。また、興味深い ことに, δバンドと εバンドの分散形状は Fig. 1(b) に示し たカゴメ格子由来のバンド分散と比較的良い一致を示す。 具体的には、結合エネルギー ($E_{\rm B}$) ~ 0.3 eV で δ バンドと ϵ バンドが交差してディラックコーン型の分散を形成し、さ らにδバンドがE_Fの直上で鞍点構造を形成する。以上の バンドに加えて M 点では V 3dx2/3dv2 軌道に由来する ζバ ンドとηバンドがそれぞれ E_B~0.05 eV 付近と 0.45 eV 付 近に存在する。

2-2. バンド構造に対する Nb 置換効果

Fig. 3(a) と Fig. 3(b) は, Nb 置換前 (x = 0) と置換後 (x = 0.07) の試料について T = 120 K で ΓKM カットに沿って測 定した ARPES 強度の比較である。両測定とも, Γ 点の電



Figure 2 (a) ARPES-intensity map of $Cs(V_{0.93}Nb_{0.07})_3Sb_5$ at E_F plotted as a function of k_x and k_y , measured at T = 120 K with hv = 106eV, which probes $k_z \sim 0$ plane. Red, purple, and blue dashed lines are guides for the eye to trace the experimental Fermi surfaces. (b) ARPES intensity at T = 120 K measured along a yellow dotted line in (a).



Figure 3 (a), (b) ARPES-intensity plot along the Γ KM cut for x = 0 and x = 0.07, respectively, measured at T = 120 K with hv = 106 eV. Crosses show experimental band dispersion extracted from the peak positions of ARPES spectra. (c) Comparison of band dispersions between x = 0 and x = 0.07 [same as red and black crosses in (a) and (b)].

子的な α バンド,線形分散を示す $\gamma \epsilon$ バンド, M 点で鞍点 を形成する δ バンドが共通して観測されており,Nb 置換 後もバンド構造に大きな変化は見られない。そこで,それ ぞれのバンド分散の定量的な違いの有無を詳しく調べるた め,Fig. 3(a) と Fig. 3(b)のスペクトルのピーク位置を抜き 出して実験的なバンド分散を決定し,直接比較した結果が Fig. 3(c)である (赤と黒の十字)。一見したところ,Nb 置 換前後のバンド構造はよく重なり合っている。しかしよく 見ると, α バンドのエネルギー位置にわずかな違いがあり, Nb 置換によって 20 meV ほど下方にシフトしていること を見出した。また,Nb 置換によって M 点の ϵ バンドの底 と η バンドのトップが約 20 meV 下方にシフトしているこ とも分かる。これらの結果は,Nb 置換が Sb 由来と V 由 来の両方のバンドに影響を与えていることを示している。

α, ε, η バンドの下方へのシフトとは対照的に, E_F 近 傍の γ および δ バンドは比較的変化がないように見える。 この点について更に詳しく検証するため、より高いエネル ギー分解能で x = 0, 0.03, 0.07 の 3 つの組成に対して MK カットで測定した ARPES 強度プロットを Fig. 4(a)-4(c) に 示す。M 点と K 点の中間で E_F を切る δ バンドは共通して 見られるが、その強度分布に違いがあることが分かる。具 体的には、Nb 置換前は M 点に強度の極大があるが、置換



Figure 4 (a)-(c) ARPES intensity near E_F around the M point measured with the He-Iα line (hv = 21.218 eV) for x = 0, 0.03, and 0.07, respectively, plotted as a function of binding energy and the k_y value in units of the MK length, $k_y/|k_{MK}|$. Temperature of the measurement was set above T_{CDW} (120, 90, 120 K for x = 0, 0.03, and 0.07, respectively). (d) Comparison of experimental band dispersions in the E- k_y window shown by a black dashed box in (a) among x = 0 (black circles), 0.03 (blue circles), and 0.07 (red circles). Inset shows the representative fitting result (green curve) to the EDC at the k_F point for x =0.07 (red circles). The k_F point is indicated by black arrow in (d). The fitting assumes a single Lorentzian peak (black curve) multiplied by the Fermi-Dirac distribution function convoluted with a resolution function.

後はそれが M 点からわずかに離れており,この結果はフ ェルミ波数 ($k_{\rm F}$)のわずかな違いを示唆している。 δ バンド の分散の定量的な変化を明らかにするために,各組成にお けるエネルギー分布曲線(EDC)スペクトルに対してフィ ッティングを行った [代表的なフィッティング結果を Fig. 4(d)の挿入図に示す]。Fig. 4(d)のバンド分散の直接比較 から, $E_{\rm F}$ のごく近傍では Nb 置換量の増加につれてバンド の傾きが増加し, $k_{\rm F}$ が系統的に M 点から遠ざかる様子を 見出した。これは、Nb 置換によってK 点における三角形 のフェルミ面が縮小することを示しており、Γ 点の電子フ ェルミ面の拡大とは対照的な振る舞いである。このような バンド / フェルミ面の逆向きのシフトは、Γ 点と K 点付近 でキャリア量が補償しあっていることを示唆しており、V と Nb による等価元素置換によって有効なキャリアドーピ ングが生じないことと矛盾しない。

2-3. Nb 置換による CDW ギャップの変調

CDW に対する Nb 置換の効果を明らかにするため に、CDW が 最も 強く 抑 制 される x = 0.07 に 対して T_{CDW} (= 58 K) より低い T = 10 K で高分解能 ARPES 測定を 行った。Fig. 5(a) は、MK カットに沿って測定した ARPES 強度を示している。Fig. 4(c) の T = 120 K の場合とは異な り、 $E_{B} \sim 60$ meV と~ 20 meV に 2 つの強度の極大が存在し





ており、それぞれδバンドで開く大きな CDW ギャップ と、 $k_{r} = \pi$ の浅い電子バンド(κ)で開く小さな CDW ギャ ップのエネルギーに関連している [11]。これは、光電子の 有限の脱出深さに起因する k. ブロードニング効果,及び, c 軸方向に 2 倍周期を持つ 3 次元 CDW を反映し、k_z=0 と k=πの電子状態を同時に観測していることに対応する(な お、CDWの面内2×2周期によって誘起されるバンドの折 り返しは、同じ実験条件で行われた以前の研究[11]の場 合と同様に, 行列要素効果により明確には観測されてい ない)。Fig. 5(b)の実験的バンド分散に見られるように、δ とκの両バンドとも M 字型の分散を示している。続いて, これらのバンドについて温度変化測定を行った。Fig. 5(c) に δ バンドの k_F で測定した EDC を示すが, T = 10 K では 大きな CDW ギャップ ($E_{\rm F}$ と δ バンドのエネルギー差: Δ_{δ}) に対応する約 60 meV の肩構造と、小さな CDW ギャップ (E_Fと κ バンドのエネルギー差:Δ_k) に対応する約 20 meV のピークが見られる。温度の上昇にしたがって、これらの 特徴的な構造は消失していくように見える。ギャップの 明瞭化のため E_F について EDC を対称化すると [Fig. 5(d)], 低温では CDW ギャップに起因して E_F 付近で強度の凹み が見られるのに対して、T = 60-70 K で凹みがほぼ消失し ている。この温度は, x = 0の T_{CDW} (93 K) よりも低いため, Nb 置換によって CDW ギャップが閉じる温度が低下して いる。Fig. 5(e) に示したギャップサイズ (Δ₈ と Δ₈) の温度 依存性から,各組成においてギャップサイズが T_{cDW}をオ ンセットとする平均場近似(実線)に従った温度依存性を 示すことを見出した。この結果からも観測したギャップの 起源が CDW であることが支持される。加えて, Fig. 5(f) に示す T = 10 K での CDW ギャップの大きさと T_{CDW} の比 較では、 Δ_{δ} と T_{CDW} のNb置換量x依存性がよく重なって おり, T_{cDW} と CDW ギャップのスケーリングが示唆される。

2-4. Nb 置換による CDW および超伝導変調の起源

以上の結果は CDW や超伝導のメカニズムに重要な示唆 を与える。第一に、Nb置換に伴ってδバンドが低結合エ ネルギー側ヘシフトするという結果は、カゴメ格子に特 徴的なバンド構造である鞍点も Er から離れることを意味 する。このことは、Nb 置換による T_{CDW} の低下が、鞍点 の E_r からのわずかな逸脱と関連していることを示唆して おり, 鞍点間の電子散乱が面内 2×2 周期の CDW を安定化 させていることを裏付けている。第二に、CDW は超伝導 状態でも存在するため,超伝導対形成は CDW ギャップが 存在しない金属的な波数領域で起こるはずであることを考 慮すると[11], CDW 相でもギャップレスな特徴を維持す る α バンドが超伝導に重要な役割を果たすと考えられる。 Nb 置換によって α ポケットの下方へのシフトが観測され たことから、E_Fにおける状態密度が増加することが予想 される。さらに、Nb 置換による CDW ギャップの抑制は、 ブリルアンゾーン境界付近のV由来の状態密度も増加さ せる。これらの状態密度の増加が T_cの上昇に寄与するこ とが示唆される。したがって、本研究で観測された δ バン ドとαバンドの逆向きのシフトは, Sb 由来と V 由来の両 方の電子にとって超伝導に有利な条件をもたらし,より高 い T。での超伝導を協調的に促進することにつながる。

3. まとめ

カゴメ格子超伝導体 CsV₃Sb₅の V を同族の Nb で置換 した試料について Photon Factory BL-28A などを用いて ARPES 測定を行い, Nb 置換が電子状態に与える影響を明 らかにした。Nb 置換により, V 由来の δ バンドは上向き に, Sb 由来の α バンドは下向きにシフトする逆位相の変 化を見出した。また, δ バンドが E_F に近いほど T_{CDW} が高 くなることを見出し, 鞍点構造と CDW の密接な関係を明 らかにした。また, Nb 置換による T_c の上昇は, Sb 由来 の α ポケットの拡大と E_F における V 由来の状態密度の回 復が協調して引き起こされていると結論した。

謝辞

本研究は、北京理工大学の Zhiwei Wang, Yongkai Li, Yugui Yao, 東北大学の相馬清吾, 組頭広志, 高橋 隆, 分 子科学研究所の松井文彦, 高エネルギー研究機構の北村未 歩,量子科学技術研究機構の堀場弘司の各氏との共同研究 によるものであり,この場を借りて厚くお礼申し上げます。 また,本研究に係る論文 [14] は 2022 年度 PF-UA 学生論 文賞を受賞しました。この場を借りて感謝申し上げます。 本 研 究 は JST-CREST (No. JPMJCR18T1), JST-PRESTO (No. JPMJPR18L7),科学研究費補助金 (No. JP21H04435, JP20H01847), KEK-PF (No. 2021S2-001), UVSOR (No. 22IMS1205),日本科学協会笹川科学研究助成,東北大学 GP-Spin, JST-SPRING (No. JPMJSP2114) などの支援を受 けて行われました。

引用文献

- B. R. Ortiz, L. C. Gomes, J. R. Morey, M. Winiarski, M. Bordelon, J. S. Mangum, I. W. H. Oswald, J. A. Rodriguez-Rivera, J. R. Neilson, S. D. Wilson, E. Ertekin, T. M. McQueen, and E. S. Toberer, Phys. Rev. Mater. 3, 094407 (2019).
- [2] T. Neupert, M. M. Denner, J.-X. Yin, R. Thomale, and M. Z. Hasan, Nat. Phys. 18, 137 (2022).
- [3] B. R. Ortiz, S. M. L. Teicher, Y. Hu, J. L. Zuo, P. M. Sarte, E. C. Schueller, A. M. Milinda Abeykoon, M. J. Krogstad, S. Rosenkranz, R. Osborn, R. Seshadri, L. Balents, J. He, and S. D. Wilson, Phys. Rev. Lett. **125**, 247002 (2020).
- [4] Y.-X. Jiang *et al.*, Nat. Mater. **20**, 1353 (2021).
- [5] T. Park, M. Ye, and L. Balents, Phys. Rev. B 104, 035142 (2021).
- [6] R. Nandkishore, L. S. Levitov, and A. V. Chubukov, Nat. Phys. 8, 158 (2012).
- [7] X. Wu, T. Schwemmer, T. Muller, A. Consiglio, G. Sangiovanni, D. Di Sante, Y. Iqbal, W. Hanke, A. P. Schnyder, M. M. Denner, M. H. Fischer, T. Neupert, and

R. Thomale, Phys. Rev. Lett. 127, 177001 (2021).

- [8] K. Y. Chen, N. N. Wang, Q. W. Yin, Y. H. Gu, K. Jiang, Z. J. Tu, C. S. Gong, Y. Uwatoko, J. P. Sun, H. C. Lei, J. P. Hu, and J.-G. Cheng, Phys. Rev. Lett. **126**, 247001 (2021).
- [9] H. Yang, Y. Zhang, Z. Huang, Z. Zhao, J. Shi, G. Qian, B. Hu, Z. Lu, H. Zhang, C. Shen, X. Lin, Z. Wang, S.J. Pennycook, H. Chen, X. Dong, W. Zhou, and H.-J. Gao, Sci. Bull. 67, 2176 (2022).
- [10] Y. Li, Q. Li, X. Fan, J. Liu, Q. Feng, M. Liu, C. Wang, J.-X. Yin, J. Duan, X. Li, Z. Wang, H.-H. Wen, and Y. Yao, Phys. Rev. B 105, L180507 (2022).
- [11] K. Nakayama, Y. Li, T. Kato, M. Liu, Z. Wang, T. Takahashi, Y. Yao, and T. Sato, Phys. Rev. B 104, L161112 (2021).
- [12] K. Nakayama, Y. Li, T. Kato, M. Liu, Z. Wang, T. Takahashi, Y. Yao, and T. Sato, Phys. Rev. X 12, 011001 (2022).
- [13] T. Kato, Y. Li, T. Kawakami, M. Liu, K. Nakayama, Z. Wang, A. Moriya, K. Tanaka, T. Takahashi, Y. Yao, and T. Sato, Commun. Mater. 3, 30 (2022).
- [14] T. Kato, Y. Li, K. Nakayama, Z. Wang, S. Souma, F. Matsui, M. Kitamura, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Takahashi, Y. Yao, and T. Sato, Phys. Rev. Lett. 129, 206402 (2022).
- [15] T. Kato, Y. Li, K. Nakayama, Z. Wang, S. Souma, M. Kitamura, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Takahashi, and T. Sato, Phys. Rev. B 106, L121112 (2022).
- [16] T. Kato, Y. Li, M. Liu, K. Nakayama, Z. Wang, S. Souma, F. Matsui, M. Kitamura, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Takahashi, Y. Yao, and T. Sato, Phys. Rev. B 107, 245143 (2023).

(原稿受付日:2023年12月11日)

著者紹介

加藤剛臣 Takemi KATO



東北大学 大学院理学研究科 博士後 期課程3年

〒 980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉 6-3

e-mail: t.kato@arpes.phys.tohoku.ac.jp

科博士前期課程修了,同博士後期課程進学。

最近の研究:角度分解光電子分光によるカゴメ格子超伝導 体の研究。

中山耕輔 Kosuke NAKAYAMA



東北大学 大学院理学研究科 助教 〒 980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉 6-3

e-mail: k.nakayama@arpes.phys.tohoku. ac.jp

● 略歷:東北大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。

最近の研究:角度分解光電子分光による新奇超伝導体やト ポロジカル絶縁体関連物質の研究。

佐藤宇史 Takafumi SATO



東北大学材料科学高等研究所 教授 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区 片平 2-1-1

e-mail: t-sato@arpes.phys.tohoku.ac.jp 略歷:2002年東北大学大学院理学研究 科物理学専攻博士後期課程修了,2002

年日本学術振興会特別研究員 (PD), 2002 年東北大学大 学院理学研究科助手, 2007 年同助教, 2010 年同准教授, 2017 年同教授, 2019 年東北大学材料科学高等研究所教授。 博士(理学)。

最近の研究:トポロジカル物質の電子状態。